

Střední průmyslová škola elektrotechnická v Brně, Kounicova 16

Jméno a příjmení: MICHAL KUČHTA	Třída: S4P	Skupina:
LABORATORNÍ CVIČENÍ Z ELEKTROTECHNICKÝCH MĚŘENÍ		
Název úlohy: Měření vlastností fotosoučástek	Č. úlohy:	
Zkoušený předmět: Fotodioda, Fotorezistor		
Datum měření: 11.1.2006	Počet stran: 6	
Datum odevzdání: 1.2.2006	Počet grafických příloh: 3	
Podpis žáka:	Klasifikace:	

Zadání, schéma, měřící přístroje, rozbor úlohy, postup měření, zpracování měření, hodnocení výsledků

ZADÁNÍ:

- 1) Změřte závislost fotoodporu na osvětlení
- 2) Změřte napětí fotodiody na prázdko v závislosti na osvětlení
- 3) Změřte VA charakteristiku fotodiody

SCHÉMA ZAPOJENÍ:

Schéma pro měření odporu fotorezistoru

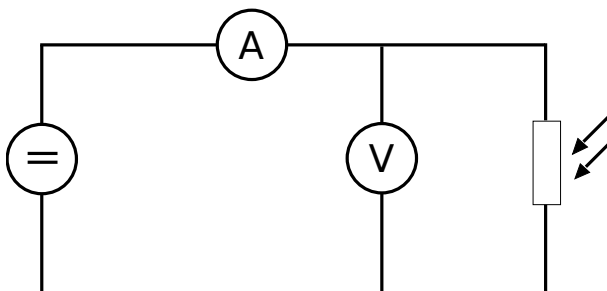


Schéma pro měření napětí na fotodiodě naprázdno

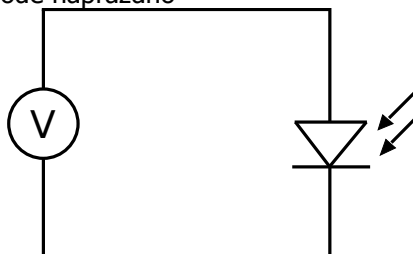
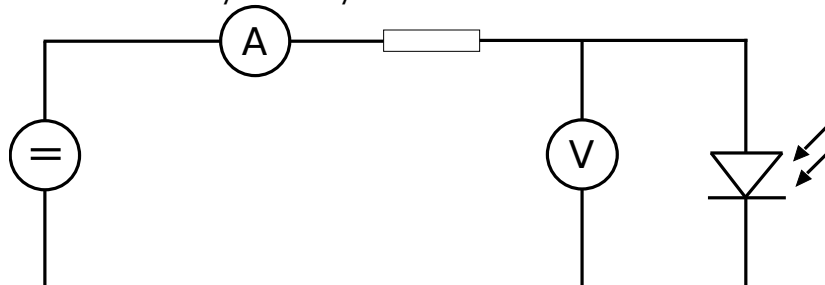


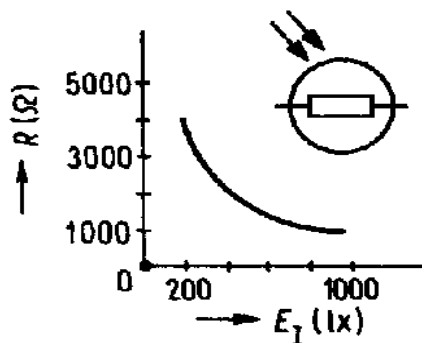
Schéma pro měření VA charakteristiky fotodiody



ROZBOR:

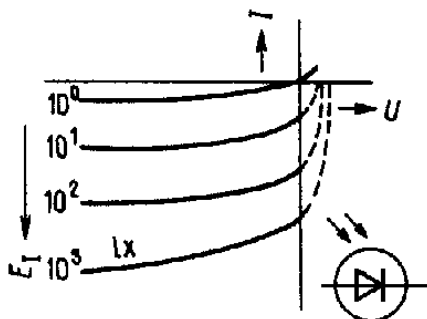
Jak fotorezistor tak fotodioda jsou součástky citlivé na světlo. Obě jsou používány pro detekci intenzity světla, se kterou mění svůj odpor.

Fotorezistor je elektrická součástka, jejíž odpor klesá se zvyšující se intenzitou světla. Součástka je vyrobena z polovodičové vrstvy citlivé na světlo. Polovodičová vrstva má ve tmě velký odpor. Dopadající světlo dodá této polovodičové vrstvě energii potřebnou k průchodu elektronů přes přechod a tím se sníží odpor.



Schématická značka a závislost odporu (R) na intenzitě osvětlení (E)

Fotodioda je obyčejný PN přechod, jaký najdeme u normální diody. Jediným rozdílem je, že na tento přechod může dopadat světlo, takže dochází k fotoelektrickému jevu. Fotodiody mohou být používány jak v propustném, tak v závěrném směru. V propustném dopadající světlo způsobí vznik napětí na diodě, které je možné měřit. Tomuto jevu se říká fotovoltaický jev, který je základem solárních článků pro výrobu elektrické energie. V závěrném směru má dioda velký odpor, ten se ale s dopadajícím světlem zmenšuje. Proto můžeme diodu použít také jako detektor světla podobně jako fotorezistor. Obvody s diodou používanou v závěrném směru bývají citlivější na světlo než ty v propustném.



VA charakteristika fotodiody v závěrném směru v závislosti na osvětlení, schématická značka

POSTUP:

Závislost fotoodporu na osvětlení

Zapojíme obvod podle schématu. Postupně nastavujeme intenzitu světla od 800lx po 50lx s krokem 50lx, odečítáme napětí a proud a dopočítáme odpor.

Napětí na fotodiodě naprázdno

K diodě připojíme voltmetr podle schématu. Postupně nastavujeme intenzitu světla od 800lx po 50lx s krokem 50lx a odečítáme napětí na voltmetru.

Měření VA charakteristiky fotodiody

Zapojíme obvod podle schématu. Na přípravku nastavíme intenzitu světla na 600lx a změříme postupně hodnoty tak, že vždy nastavíme U a odečteme I . Po změření všech 10ti hodnot změníme intenzitu světla na 400lx a měření opakujeme. To samé pro 200lx.

TABULKY NAMĚŘENÝCH A VYPOČÍTANÝCH HODNOT

Závislost fotoodporu na osvětlení

t = 20°C

E	U_x	I	R_x
lx	V	mA	kΩ
800	4,56	10,2	0,45
750	4,47	10,0	0,45
700	4,48	9,8	0,46
650	4,50	9,4	0,48
600	4,49	9,0	0,50
550	4,51	8,6	0,52
500	4,50	8,4	0,54
450	4,51	8,0	0,56
400	4,55	8,0	0,57
350	4,57	7,8	0,59
300	4,59	7,2	0,64
250	4,63	6,6	0,70
200	4,20	6,4	0,66
150	4,72	5,2	0,91
100	4,78	4,2	1,14
50	4,84	3,2	1,51

Napětí na fotodiodě naprázdno

t = 20°C

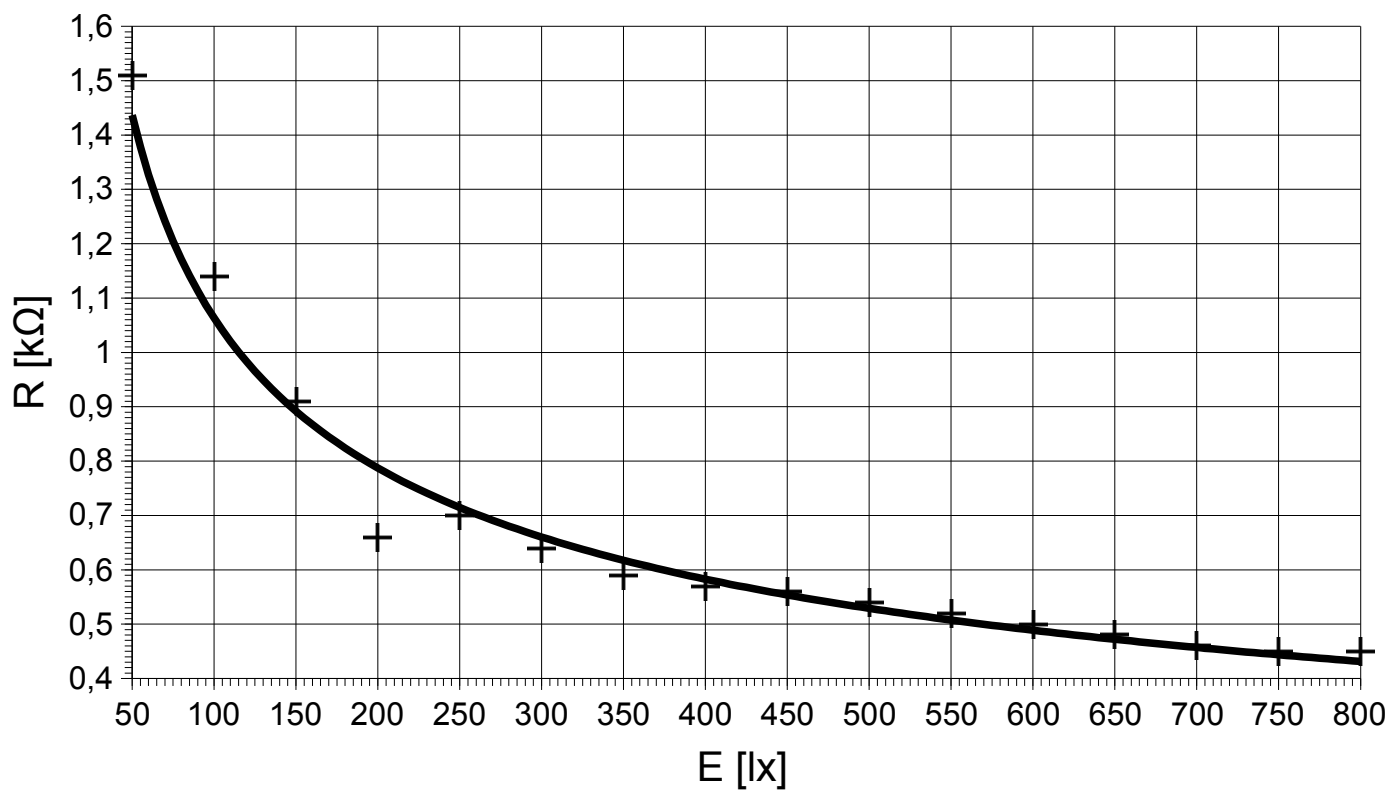
E	U
lx	V
800	0,349
750	0,340
700	0,335
650	0,333
600	0,327
550	0,322
500	0,320
450	0,315
400	0,312
350	0,306
300	0,300
250	0,293
200	0,282
150	0,257
100	0,240
50	0,215

VA charakteristika fotodiody

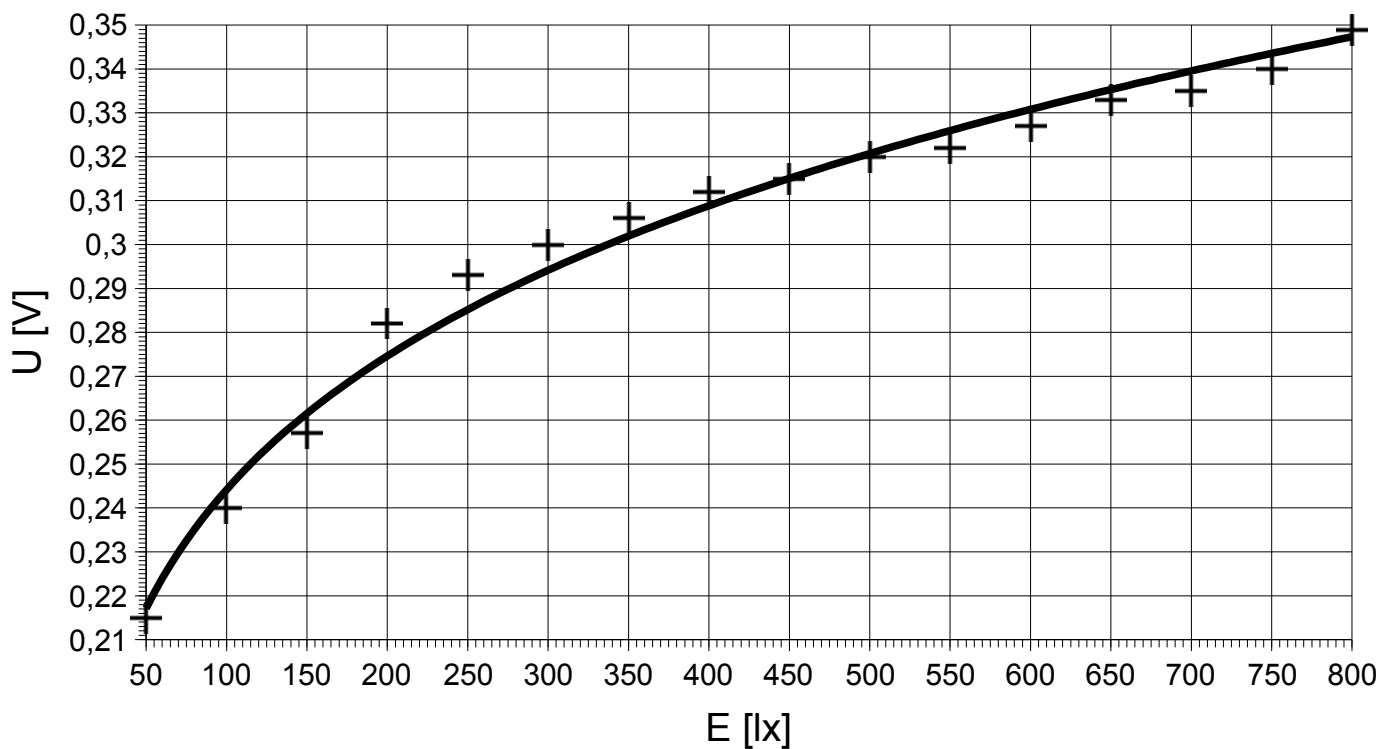
t = 20°C

600lx			400lx			200lx		
U_z	I₀	U_D	U_z	I₀	U_D	U_z	I₀	U_D
V	mA	V	V	mA	V	V	mA	V
1	0,06	0,330	1	0,08	0,34	1	0,06	0,33
2	0,15	0,388	2	0,16	0,39	2	0,18	0,38
3	0,26	0,430	3	0,26	0,44	3	0,27	0,42
4	0,36	0,451	4	0,35	0,45	4	0,37	0,45
5	0,47	0,473	5	0,46	0,47	5	0,47	0,43
6	0,56	0,489	6	0,55	0,48	6	0,57	0,45
7	0,64	0,500	7	0,64	0,50	7	0,68	0,46
8	0,76	0,514	8	0,75	0,51	8	0,78	0,51
9	0,87	0,524	9	0,84	0,52	9	0,88	0,52
10	0,98	0,530	10	0,96	0,53	10	0,98	0,53

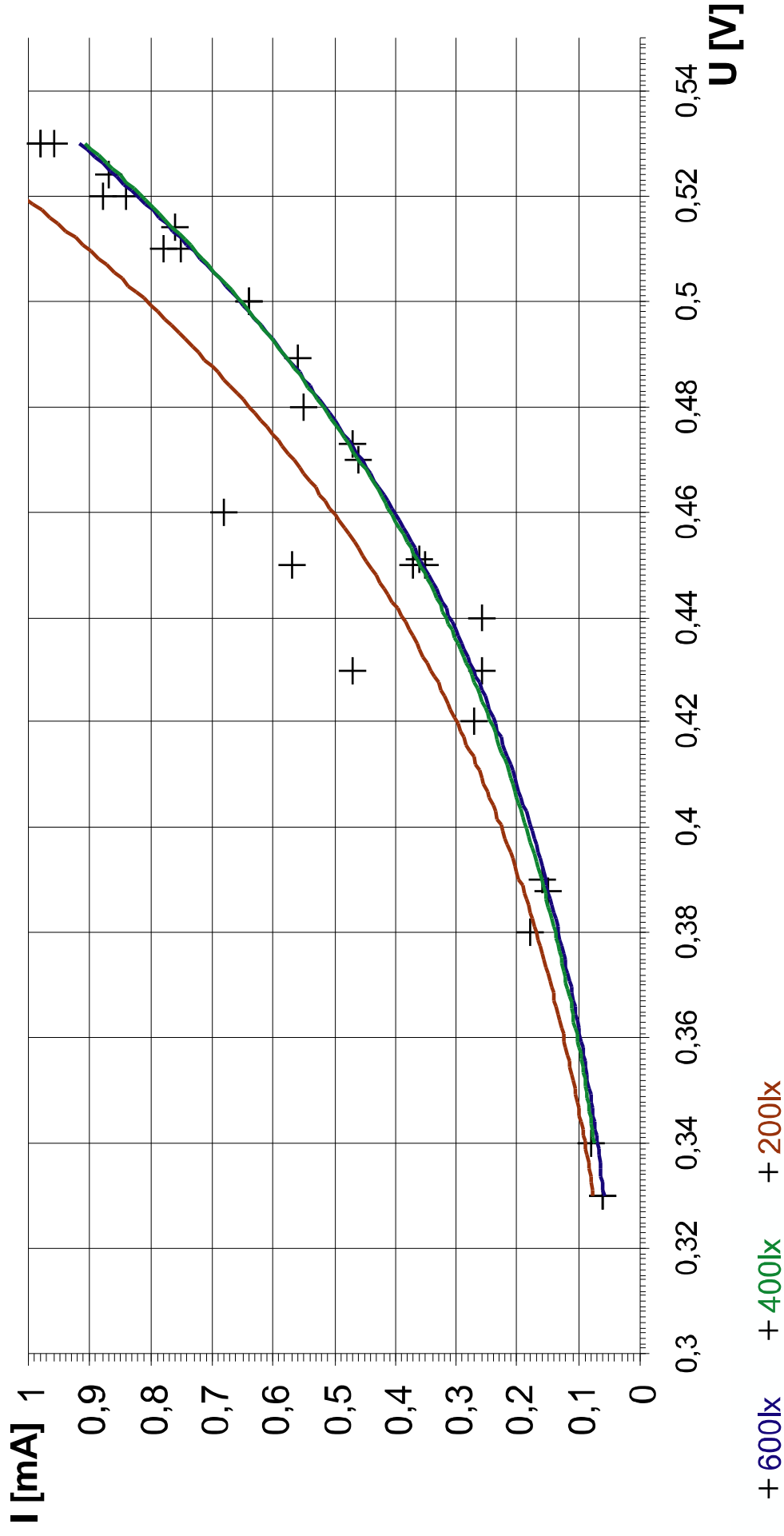
Závislost fotoodporu na osvětlení



Napětí na fotodiode naprázdno



VA charakteristika fotodiody



ZÁVĚR:

Měřením jsme ověřili, že teoretické předpoklady skutečně platí. Odpor fotorezistoru se s intenzitou světla zmenšoval, na diodě naprázdno se měnilo napětí v závislosti na intenzitě, a VA charakteristika se s intenzitou světla neměnila. V grafu u křivky 200lx došlo k menší chybě při měření, proto je aproximovaná přímka o trochu jině než zbylé dvě.

